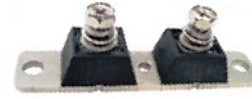
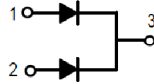


## Silicon Schottky Diode, 200A

### Features

- Guard Ring Protection
- Low forward voltage drop
- High surge current capability
- Up to 100V  $V_{RRM}$



TWIN TOWER PACKAGE

### Maximum Ratings ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

| Parameter                                            | Symbol      | Conditions                                        | MBR20045CT<br>(R) | MBR20060CT<br>(R) | MBR20080CT<br>(R) | MBR200100C<br>T(R) | Units |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Repetitive peak reverse voltage                      | $V_{RRM}$   |                                                   | 45                | 60                | 80                | 100                | V     |
| RMS reverse voltage                                  | $V_{RMS}$   |                                                   | 32                | 42                | 56                | 70                 | V     |
| DC blocking voltage                                  | $V_{DC}$    |                                                   | 45                | 60                | 80                | 100                | V     |
| Average forward current                              | $I_{F(AV)}$ | $T_C \leq 135^\circ\text{C}$                      | 200               | 200               | 200               | 200                | A     |
| Non-repetitive forward surge current, half sine-wave | $I_{FSM}$   | $T_C = 25^\circ\text{C}$<br>$t_p = 8.3\text{ ms}$ | 1500              | 1500              | 1500              | 1500               | A     |

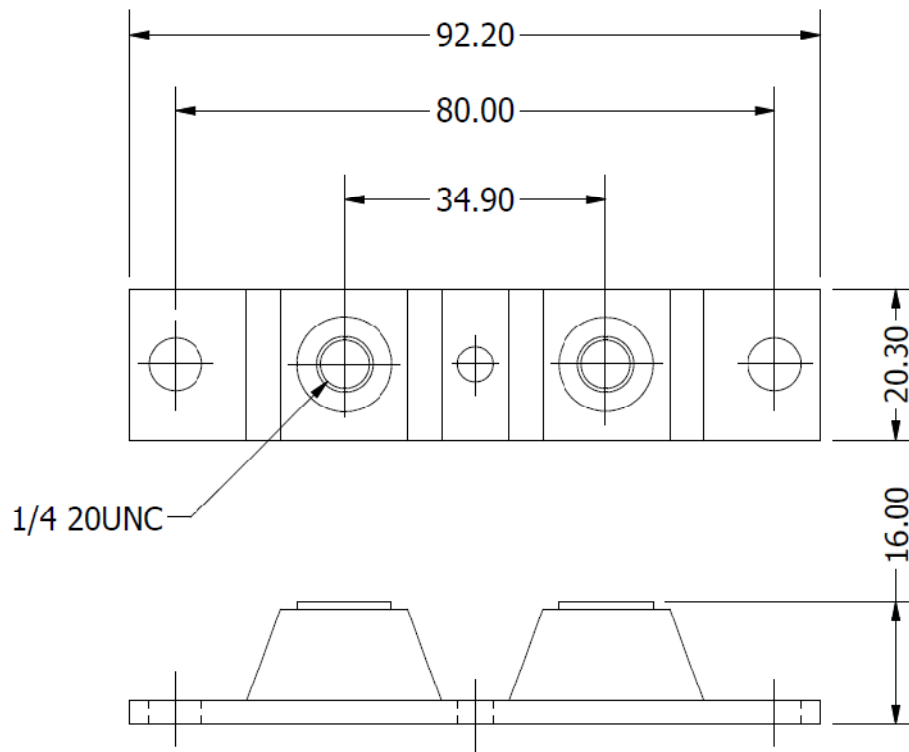
### Electrical Characteristics ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

| Parameter          | Symbol | Conditions                                       | MBR20045CT<br>(R) | MBR20060CT<br>(R) | MBR20080CT<br>(R) | MBR200100C<br>T(R) | Units |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| DC forward voltage | $V_F$  | $I_F = 100\text{ A}$<br>$T_J = 25^\circ\text{C}$ | 0.68              | 0.76              | 0.88              | 0.88               | V     |
| DC reverse current | $I_R$  | $V_R = 20\text{ V}$<br>$T_J = 25^\circ\text{C}$  | 5                 | 5                 | 5                 | 5                  | mA    |
|                    |        | $V_R = 20\text{ V}$<br>$T_J = 125^\circ\text{C}$ | 200               | 200               | 200               | 200                |       |

### Thermal Characteristics ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

| Parameter                            | Symbol         |  | MBR20045CT<br>(R) | MBR20060CT<br>(R) | MBR20080CT<br>(R) | MBR200100C<br>T(R) | Units              |
|--------------------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Thermal resistance junction to case  | $R_{thJ-C}$    |  | 0.5               | 0.5               | 0.5               | 0.5                | $^\circ\text{C/W}$ |
| Operating, storage temperature range | $T_J, T_{stg}$ |  | - 40 to +175      | - 40 to +175      | - 40 to +175      | - 40 to +175       | $^\circ\text{C}$   |

## Package Outline



ALL DIMENSIONS IN MM

## Ordering Table

| MBR | 200 | 20 | CT |
|-----|-----|----|----|
| 1   | 2   | 3  | 4  |

- 1 – Device Type
  - > MBR = Schottky Barrier Diode Module
- 2 – Current Rating =  $I_{F(AV)}$
- 3 – Voltage =  $V_{RRM}$
- 4 – Polarity
  - > CT = Normal (Cathode to Base)
  - > CTR = Reverse (Anode to Base)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9